

## 第14回半導体材料・デバイスフォーラム プログラム

セッション	No.	氏名	所属	講演タイトル
開会		坂本 比呂志	九州工業大学大学院 情報工学研究院長	
9:05～10:35				
基調講演	I-1	若林 整	東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット 教授	先端ロジック半導体集積回路技術の最新動向と 集積Green-niX研究・人材育成拠点活動の紹介
企業招待講演	I-2	武富 太志	株式会社SUMCO ICT推進部	Manufacturing of semiconductor silicon wafers and AI/digital utilization (日本語による講演です。)
10:40～12:10 (修士・学部学生1件当たり10分+質疑2分) 学生口頭発表第1会場				
一般講演 第1会場 (学生発表)	O-1	大石 結也	九州工業大学大学院情報工学府 修士課程2年	n-Ru <sub>2</sub> Si <sub>3</sub> /p-Si pn ヘテロ接合素子における短波赤外線領域の分光感度評価
	O-2	鎌釣 一 (熊本高専卒)	九州大学大学院総合理工学府 修士課程2年	リセスチャネル構造によるメタルS/D 型Ge n-MOSFET の電流駆動力改善
	O-3	大橋 亮太	北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 修士課程2年	ペイズ最適化を適用したCat-CVD i-a-Si およびn-a-Siの堆積条件探索
	O-4	喜瀬 駆	都城工業高等専門学校 専攻科1年	二段階アニールによるCu <sub>2</sub> SnS <sub>3</sub> 薄膜作製での焼成条件の影響
	O-5	井上 和磨	名古屋大学大学院工学研究科 修士課程2年	水素化アモルファスシリコン/結晶シリコンヘテロ界面における パッシベーション機構の解明に向けた反応性力場分子動力学法による数値シミュレーション
	O-6	原 太一 (久留米高専卒)	九州大学大学院総合理工学府 修士課程1年	スパースモデリングを用いたスパッタAlN 膜の高温アニールプロセスの条件探索
	O-7	中村 友哉 (長野高専卒)	長岡技術科学大学大学院工学研究科 修士課程2年	ダイヤモンド半導体実現に向けた大型ダイヤモンド基板製造技術の開発 ～ヘテロエピタキシャルダイヤモンド成長様式の検討～
10:40～12:10 (修士・学部学生1件当たり10分+質疑2分) 学生口頭発表第2会場				
一般講演 第2会場 (学生発表)	O-8	居倉 功汰	筑波大学大学院理工情報生命学術院 数理工学物質科学研究群 修士課程1年	大粒径InGaAs 膜による近赤外分光感度実証とプラスチック上展開
	O-9	堀田 有花 (久留米高専卒)	九州工業大学工学部 電気電子工学科4年	多結晶ダイヤモンド膜のCVD 成長におけるリン添加の影響
	O-10	高細工 彩斗	熊本高等専門学校 専攻科1年	絶縁基板上における非晶質Ge薄膜のMg誘起結晶成長 (2)
	O-11	諏訪 陸矢	久留米工業高等専門学校 専攻科2年	第一原理計算や機械学習を活用した窒化ホウ素の結晶構造予測
	O-12	川野 裕大 (大分高専卒)	九州大学大学院総合理工学府 修士課程2年	アクティブMMIレーザへの適用に向けた垂直回折格子の検討
	O-13	長野 里基 (有明高専卒)	九州大学大学院総合理工学府 修士課程2年	二酸化炭素の電気化学還元に向けた 窒素ドーブ超ナノ微結晶ダイヤモンド電極の作製
	O-14	福島 匠	熊本大学大学院自然科学教育部 修士課程2年	界面準位がワイドバンドギャップ半導体MOSキャパシタの 容量-電圧特性に与える影響
12:20～13:00 昼食				
セッション No. 氏名 所属 講演タイトル				
13:00～13:30 (説明会20分+10分)				
説明会		平田 耕一	九州工業大学情報工学部 教授	九州工業大学情報工学部編入学説明会/大学院情報工学府説明会
13:30～17:00 大学セミナー				
第1会場	大学セミナープログラムをご確認ください。			
第2会場				
13:30～17:00 企業セミナー				
A会場	企業セミナープログラムをご確認ください。			
B会場				
C会場				
D会場				
E会場				
16:00～17:50 学生ポスター発表				
学生ポスター展示	ポスター発表プログラムをご確認ください。  奇数番号コアタイム : 16:15～17:00 偶数番号コアタイム : 17:00～17:45			
閉会				

## 学生ポスター発表 プログラム

No.	氏名	所属	講演タイトル
P-1	鄭 開元	九州工業大学大学院 修士課程2年	3D-LSIのTSV製造プロセス開発
P-2	石飛 新太郎	九州工業大学大学院 修士課程1年	鉄シリサイド半導体上へのひずみゲルマニウム成長
P-3	前田 真太郎	筑波大学大学院 修士課程2年	選択的核生成による多結晶GeSn合成と高移動度トランジスタの実証
P-4	太田 岳宏	熊本高等専門学校 専攻科1年	n形Mg <sub>2</sub> Si中に形成された捕獲準位のDLTS測定(2)
P-5	山下 紗英	北九州工業高等専門学校 5年	光アップコンバージョン色素系含有(高分子/液晶)複合膜の研究開発
P-6	稲富 恵衣	久留米工業高等専門学校 5年	ZnOナノ粒子を活用した植物の栄養成分の吸収・輸送経路の視覚化
P-7	菊本 翔太	熊本高等専門学校 専攻科1年	非晶質Ge薄膜のSn 誘起横方向成長(2)
P-8	遠藤 聡馬	宮崎大学 4年	光ヘテロダイン光熱変位法による転位すべり面に異方性のある InGaAs 太陽電池の非発光再結合準位の分布測定
P-9	川内 陸駆	北九州工業高等専門学校 専攻科2年	ベンチュリ管内に形成される気液二層流中でのファインバブルの 生成過程の解析
P-10	谷口 広至	都城工業高等専門学校 専攻科2年	相分離スパッタ法によるスパッタ粒子の運動エネルギーを利用した 相分離発現温度の低温化
P-11	坂井 星軌	都城工業高等専門学校 専攻科2年	相分離スパッタ技術におけるスパッタ粒子の輸送過程が 薄膜成分化学組成に与える影響
P-12	中原 大葉	熊本高等専門学校 専攻科1年	非晶質Ge/SiO <sub>2</sub> のMg 誘起横方向成長に及ぼす高圧下熱処理の影響
P-13	加藤 芳規	名古屋大学大学院 修士課程1年	Pイオン注入によるn型Ge <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> (111)エピタキシャル層の形成
P-14	末次 祐太 (舞鶴高専卒)	佐賀大学 4年	n-ZnO窓層を用いたZnTe中間バンド型太陽電池の 2段階光吸収電流の温度依存性
P-15	山形 悠太 (呉高専卒)	九州工業大学 4年	β-FeSi <sub>2</sub> p-nホモ接合における暗電流値と分光感度のSi/Fe供給比依存性
P-16	浦野 翔大	宮崎大学 4年	Siの熱拡散率とキャリアライフタイムの予測における 光ヘテロダイン光熱変位信号と機械学習モデル
P-17	松本 健佑	熊本高等専門学校 専攻科1年	廃炉ロボット用マイコン及びメモリの放射線耐性評価
P-18	石丸 純也	北九州工業高等専門学校 専攻科2年	矩形ノズルを用いた超音速噴流の噴流構造に及ぼす ノズル出口形状の影響の解析
P-19	浦上 真聡	熊本高等専門学校 専攻科1年	Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 薄膜へのGeドーピングにおける2段階熱処理の有効性
P-20	辻 康暉	北九州工業高等専門学校 専攻科2年	ファインバブル生成を目的とした小型ベンチュリ管の形状の最適化
P-21	岩下 大晟	宮崎大学 4年	ALE法で意図的に変化させたN分布がGaAsN薄膜の バンドギャップに及ぼす影響
P-22	飯田 紗輝	北九州工業高等専門学校 専攻科2年	光アップコンバージョン色素系含有光エネルギー変換フィルムの研究開発
P-23	榎原 理沙	久留米工業高等専門学校 5年	共析反応で得られたβ-FeSi <sub>2</sub> +Si複合材料の結晶方位解析
P-24	小田部 龍哉	九州工業大学大学院 修士課程2年	トポロジカル絶縁体Bi <sub>2</sub> Se <sub>3</sub> 上へのCdSe成長のSe/Cd蒸気圧比依存性
P-25	中島 魁耶	宮崎大学 4年	フォトルミネッセンス測定を用いた 波状超格子太陽電池の発光再結合の励起光強度依存性評価
P-26	森 健太郎	都城工業高等専門学校 5年	ATS薄膜の熱処理におけるH <sub>2</sub> S濃度依存性
P-27	長嶋 泰雅	熊本高等専門学校 専攻科1年	非晶質Ge/SiO <sub>2</sub> のAu誘起横方向成長に及ぼすMg層挿入効果
P-28	清水 響子	熊本高等専門学校 専攻科1年	接合面積の異なるp <sup>+</sup> n Mg <sub>2</sub> Si ダイオードのDLTS スペクトルの比較
P-29	中坂 元	都城工業高等専門学校 専攻科2年	反応性スパッタリング法におけるターゲットモード変化の臨界条件
P-30	野中 華輝	熊本高等専門学校 専攻科1年	Au/非晶質Ge/SiO <sub>2</sub> 構造の金属誘起横方向成長に及ぼす Ge膜厚の影響
P-31	脇島 海晴 (熊本高専卒)	宮崎大学大学院 修士課程2年	硝酸塩水溶液のスプレー熱分解で作製したp型CuBi <sub>2</sub> O <sub>4</sub> の 光電気化学特性
P-32	Thin Nu Soe	熊本大学大学院 修士課程2年	Formation of Cu <sub>2</sub> O thin films with mist chemical vapor deposition toward solar cell